

トランジスタ

2SA880

2SA880

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

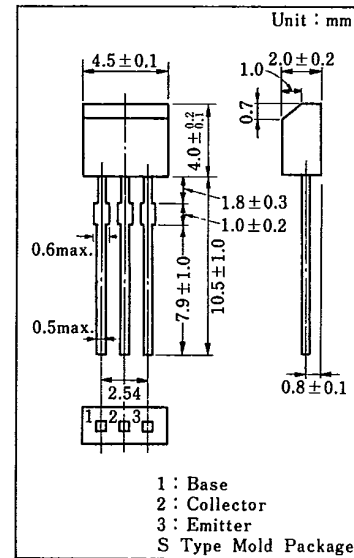
低周波低雑音増幅用 / AF Low Noise Amplifier
 2SC1787 とコンプリメンタリ / Complementary Pair with
 2SC1787

■ 特徴 / Features

- 雑音電圧 NV が低い。 / Low NV
- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きい。 / High h_{FE}

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	35	V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	35	V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CP}$	100	mA
コレクタ電流	$-I_C$	50	mA
コレクタ損失	P_C	150	mW
接合部温度	T_J	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0$			100	nA
	$-I_{CEO}$	$-V_{CE} = 10\text{ V}, I_B = 0$			1	μA
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	$-I_C = 10\ \mu\text{A}, I_E = 0$	35			V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C = 1\text{ mA}, I_B = 0$	35			V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E = 10\ \mu\text{A}, I_C = 0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$-V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 2\text{ mA}$	260		700	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C = 100\text{ mA}, -I_B = 10\text{ mA}$			0.6	V
ベース・エミッタ電圧	$-V_{BE}$	$-V_{CE} = 1\text{ V}, -I_C = 100\text{ mA}$		0.7	1	V
雑音電圧	NV	$-V_{CE} = 10\text{ V}, -I_C = 1\text{ mA},$ $G_v = 80\text{ dB}$ $R_x = 100\text{ k}\Omega, \text{Function} = \text{FLAT}$			150	mV

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	S	T
h_{FE}	260 ~ 520	360 ~ 700

トランジスタ

T-29-15 2SA880

